

シリコン パワー トランジスタ
Silicon Power Transistor
2SC3217-M

NPNエピタキシャル形シリコントランジスタ
860 MHz帯高電圧・広帯域・高周波電力増幅用
通信工業用

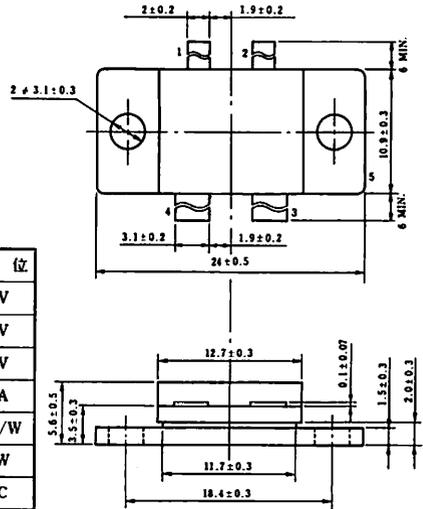
特長

- 860 MHzにて高利得・高出力が得られます。
 $P_{out}=16\text{ W}$ ($V_{CC}=24\text{ V}$, $P_{in}=2\text{ W}$, class AB)
- Push-Pull構造のため広帯域設計が容易。
- エミッタ安定化抵抗を内蔵。
- 内部整合回路内蔵。
- 金電極のため高い信頼度が得られます。

絶対最大定格 ($T_a=25\text{ }^\circ\text{C}$)

項目	略号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	50	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	32	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	3	V
コレクタ電流	I_C	12	A
熱抵抗	$R_{th(j-c)}$	1.75	$^\circ\text{C/W}$
全損失	$P_{T(j-c)}$	100	W
ジャンクション温度	T_j	200	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-65 ~ +150	$^\circ\text{C}$

外形図 (Unit: mm)



電極接続

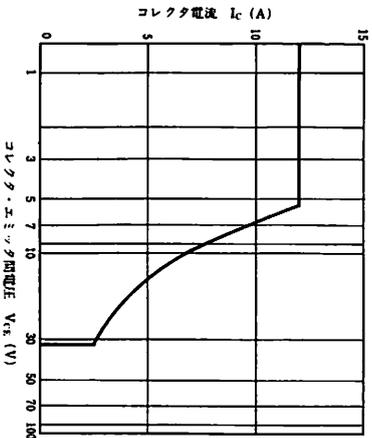
1. コレクタ
2. コレクタ
3. ベース
4. ベース
5. エミッタ (放熱板)

電氣的特性 ($T_a=25\text{ }^\circ\text{C}$)

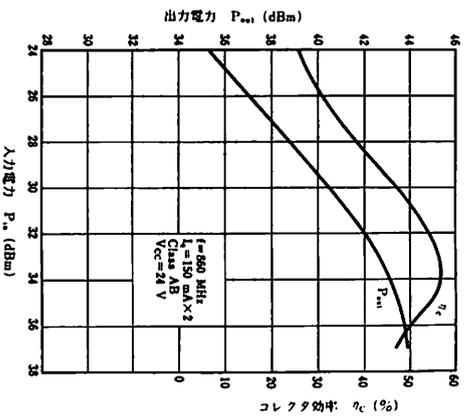
項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=30\text{ V}$, $I_E=0$			2	mA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=2\text{ V}$, $I_C=0$			2	mA
直電流増幅率	h_{FE}	$V_{CB}=10\text{ V}$, $I_C=0.8\text{ A}$ (ノルス)	20	60	120	-
出力電力	P_{out}	$f=860\text{ MHz}$, $V_{CC}=24\text{ V}$ $P_{in}=2\text{ W}$ (33 dBm)	41	42		dBm
			12.6	16		W
コレクタ効率	η_C	$I_q=150\text{ mA} \times 2$, class AB	45	50		%
掃還容量	C_{re}	$V_{CB}=28\text{ V}$, $f=1\text{ MHz}$, $I_E=0$		24	36	pF

* UNITあたり

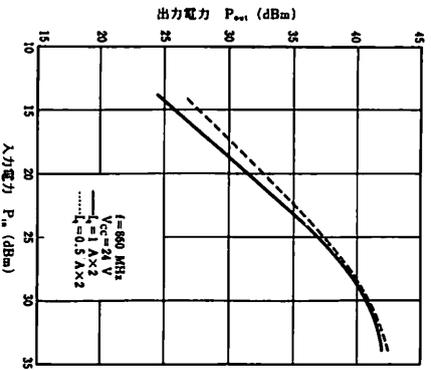
FORWARD BIAS SAFE OPERATING AREA (FBSOA)



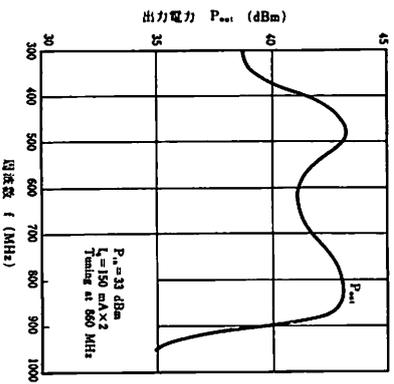
OUTPUT POWER AND COLLECTOR EFFICIENCY vs. INPUT POWER CURVE



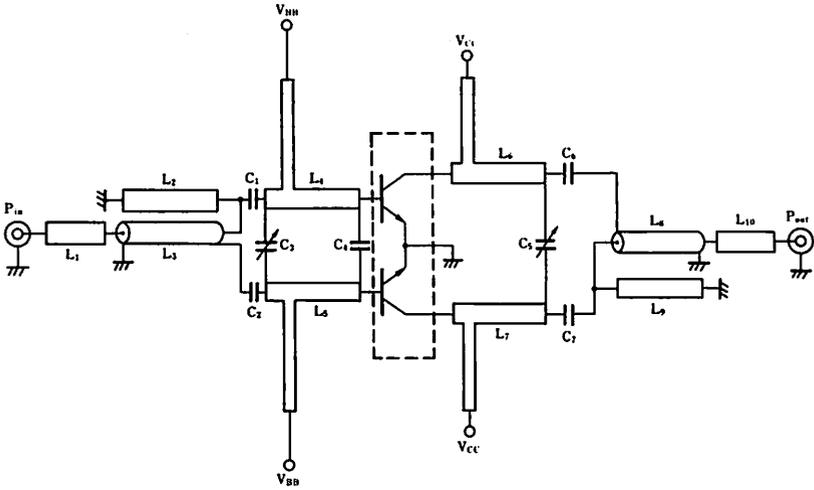
OUTPUT POWER vs INPUT POWER CURVE



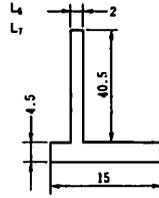
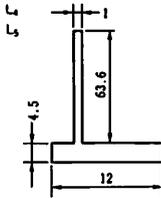
FREQUENCY RESPONSE



応用回路例



- $C_1 = C_2 = 20 \text{ pF}$
- $C_3 = 20 \text{ pF}$
- $C_4 = 10 \text{ pF}$
- $C_5 = 20 \text{ pF}$
- $C_6 = C_7 = 75 \text{ pF}$
- L_1, L_{10} マイクロストリップライン 23.6×4.5 mm
- L_2, L_9 50 Ωセミリジッドケーブル 70 mm
- $L_3 \sim L_7$ マイクロストリップライン (単位: mm)



基板材料テフロンガラス $t = 1.6 \text{ mm}$

製品取扱い上のご注意

本製品は、内部にペリリア磁器（酸化ベリリウム）を使用しております。酸化ベリリウムは、その粉末や蒸気が人体の呼吸器系に入ると呼吸困難などの障害が起こり、危険ですので、製品の分解または化学的処理はされないようお願いいたします。

また、製品を廃棄する場合は、一般産業廃棄物あるいは家庭用ゴミとは必ず別にご処分ください。